

EP 00 13666

10/069826



REC'D 17 JUL 2000

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 199 20 871.9

Anmeldetag: 06. Mai 1999

Anmelder/Inhaber: STEAG RTP Systems GmbH, Dornstadt/DE

Bezeichnung: UV-unterstützte thermische Behandlung von
Verbindungshalbleitern in RTP-Systemen

IPC: H 01 L 21/324

Bemerkung: Die Anmelderin firmierte bei Einreichung dieser
Patentanmeldung unter der Bezeichnung:
STEAG AST Elektronik GmbH

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 20. Juni 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Brand

UV-unterstützte thermische Behandlung von Verbindungshalbleitern in RTP-Systemen

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermischen Behandlung von wenigstens einer Schicht, vorzugsweise bestehend aus Verbindungshalbleitern, zur Aktivierung von in der Schicht durch Wasserstoff passivierten Fremdatomen, bei dem wenigstens eine Schicht auf eine Temperatur höher als eine erste Temperatur, bei der der spezifische Schichtwiderstand abnimmt, für ein erstes Zeitintervall kleiner als 120 Sekunden erwärmt wird.

- 10 Das beschriebene Verfahren wird zur elektrischen Aktivierung der p-Dotierung von II-VI- und III-V-Halbleitern verwendet, die durch CVD- (Chemical Vapor Deposition), insbesondere durch MOCVD- (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) Prozesse hergestellt wurden. Derartige Halbleiter werden z.B. für die
- 15 Herstellung optoelektronischer Bauelemente (z.B. lichtemittierender Bauteile wie z.B. blaue Leuchtdioden oder Laserdioden) verwendet. Während der CVD-Prozesse wird neben dem Akzeptor bei der p-Dotierung (z.B. in III-V-Halbleitern Mg, C, Zn, Be, Cd, Ca, Ba, oder in II-VI-Halbleitern N) auch Wasserstoff in die
- 20 Halbleiterschicht eingebaut. Dieser bildet mit den Akzeptoratomten einen elektrisch inaktiven Komplex, was zu einer Passivierung der Akzeptoratomten (z.B. Mg) und damit zu einem hohen Schichtwiderstand führt. Es sind mehrere Verfahren zur Aktivierung der passivierten Akzeptoratomten bekannt, bei denen die elektrisch inaktiven Wasserstoff-Akzeptor-Komplexe (oder allgemein Wasserstoff-Fremdatom-Komplex) aufgebrochen werden, und der Wasserstoff durch
- 25 Diffusion aus der p-dotierten Schicht entfernt wird.

- Ein Verfahren nach der eingangs beschriebenen Art zur Aktivierung der Wasserstoff-Akzeptor-Komplexe ist in US 5,786,233 beschrieben, wobei während
- 30 des Verfahrens das Substrat mit kurzwelligem Licht bestrahlt wird, dessen Photonenenergie größer als der Bandabstand bei der Verfahrenstemperatur ist.

Vorzugsweise werden die Substrate für eine Dauer von zwei bis 30 Minuten auf Temperaturen von ca. 650 C bis 800 C erhitzt. Dabei werden die Komplexe aufgebrochen und die zuvor passivierten Akzeptoren (z.B. GaN:Mg) aktiviert, wodurch sich der Schichtwiderstand um bis zu mehreren Größenordnungen verringert bzw. die Löcherkonzentration entsprechend erhöht. Durch das Bestrahlen mit kurzwelligem Licht läßt sich die Aktivierung der Akzeptoren und damit die Löcherkonzentration deutlich erhöhen. Da bei noch höheren Temperaturen die Schicht jedoch thermisch geschädigt wird und die p-Leitfähigkeit mit zunehmender Behandlungsdauer wieder abnimmt, ist nach US 5,786,233 ein längeres annealen bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen vorzugsweise anzuwenden.

Yoichi Kamiura et al.; Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) L970-L971 beschreibt den Einfluß von UV-Strahlung auf die Mg-Aktivierung bei GaN-Filmen. Dabei werden die GaN-Filme in einem Ofen für ca. eine Stunde auf einer Temperatur höher als eine Aktivierungstemperatur von ca. 550 C gehalten. Bei Bestrahlung der Mg-dotierten GaN-Schicht mit UV-Strahlung läßt sich die Aktivierungstemperatur etwa um 100 C reduzieren, wodurch sich die thermische Belastung der Substrate ebenfalls reduziert.

In EP 0723303 wird ein aus Heterostrukturen aufgebautes, lichtemittierendes elektronisches Bauteil und ein Verfahren zu dessen Herstellung beschrieben, bei dem bei etwa 600 C mit Hilfe von UV-Laserstrahlung ein Annealing durchgeführt wird, um die Akzeptoraktivierung in den Schichten zu erhöhen bzw. den Schichtwiderstand zu erniedrigen.

In Mamoru Miyachi et al.; Appl. Phys. Lett., Vol 72, No 9, 1101 (1998) wird die thermische Aktivierung von Mg in GaN mit zusätzlicher Generation von Ladungsträgern beschrieben, die durch Anlegen einer Spannung an die Halbleiterstruktur erzeugt werden. Ebenso wird darauf verwiesen, daß ein p-leitendes Verhalten von Mg enthaltendem GaN auch durch ein Bestrahlen mit niedere-

nergetischen Elektronen erzielt und beeinflußt werden kann.

Alle bisher beschriebenen Verfahren dienen zur Aktivierung der durch Wasserstoff passivierten Akzeptoren. Der Nachteil der oben beschriebenen Verfahren ist, daß zur Aktivierung vergleichsweise lange Prozeßzeiten notwendig sind, wobei im allgemeinen die Substrate (z.B. Saphir, SiC, Si, AlN, ZnO oder Al₂O₃) mit den darauf befindlichen Halbleiterfilmen einer hohen thermischen Belastung ausgesetzt sind, und die Durchsatzzahlen zudem sehr niedrig sind.

10 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es diese Nachteile zu beseitigen.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß bei dem eingangs beschriebenen Verfahren innerhalb des ersten Zeitintervalls wenigstens eine Schicht auf eine zweite Temperatur höher als die erste Temperatur für ein zweites Zeitintervall von bis zu 60 Sekunden erwärmt wird, wobei während des Verfahrens in wenigstens einem dritten Zeitintervall durch elektromagnetische Strahlung innerhalb der Schicht Ladungsträger erzeugt werden.

20 Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird vorteilhaft die Prozessdauer zur Aktivierung der durch Wasserstoff passivierten Fremdatome (z.B. Mg) in einer oder mehreren aus Verbindungshalbleitern bestehenden Schichten (z.B. GaN) wesentlich verkürzt, wobei Schichtwiderstand und Löcherkonzentration mit den oben beschriebenen bekannten Verfahren vergleichbar sind.

25 Das erfindungsgemäße Verfahren wird bevorzugt in Schnellheiz- oder RTP- (Rapid Thermal Processing) Systemen durchgeführt, da in RTP-Systemen die Halbleiter mit sehr präzisen Temperatur-Zeit-Prozessen und sehr hoher Gleichförmigkeit prozessierbar sind.

30 Die erste Temperatur des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zwischen 350 C und 900 C gewählt, wobei z.B. bei Mg enthaltendem GaN (oder allgemein bei

Gruppe-III-Nitriden) eine Temperatur zwischen 350 C und 600 C bevorzugt wird. Abhängig vom Halbleitertyp kann die erste Temperatur auch von der Wahl des dritten Zeitintervalls und von der Intensität der elektromagnetischen Strahlung und der damit verbundenen Generation an Minoritätsladungsträger abhängen. Mit zunehmender Länge des dritten Zeitintervalls und mit zunehmender Intensität der elektromagnetischen Strahlung läßt sich je nach Halbleitertyp die erste Temperatur absenken, was vorteilhaft zu einer Reduktion der thermischen Belastung der Schicht führt.

10 Die zweite Temperatur während des zweiten Zeitintervalls wird vorzugsweise zwischen 700 C und 1400 C gewählt. Die Wahl dieser Temperatur hängt wesentlich vom Material des Verbindungshalbleiters ab, wobei z.B. bei Mg enthaltendem GaN vorzugsweise eine zweite Temperatur zwischen 850 C und 1200 C gewählt wird. Durch die Wahl einer höheren zweiten Temperatur kann vorteilhaft das zweite Zeitintervall wesentlich verkürzt werden, was ebenfalls wieder zu einer Reduktion der thermischen Belastung der Halbleiterschicht bzw. des Halbleiterschichtsystems führt.

15 Eine Erwärmung des Halbleiters auf eine zweite Temperatur höher als die Zersetzungstemperatur kann für kurze Zeit erfolgen. Wird die Halbleiterschicht an ihrer Oberfläche mit einer Beschichtung (z.B. SiO_2) versehen, oder wird die Halbleiterschicht unter Überdruck z.B. in einer wasserstofffreien N_2 -Atmosphäre erhitzt, so findet eine Zersetzung der Verbindungshalbleiter erst bei höheren Temperaturen statt, wodurch die zweite Temperatur weiter erhöht werden kann. Zeit und Temperatur werden dabei so gewählt, daß z.B. im Falle von Mg dotiertem GaN die durch Stickstofffehlstellen entstandenen Donatorzentren die Zahl der aktiven Mg-Zentren (allgemein aktiven Aktivatorzentren) nicht übersteigt, so daß insbesondere ein p-leitendes Verhalten der Schicht resultiert. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit die Konzentration und Aktivierung von Donator- und Akzeptorzentren in weiten Bereichen einzustellen.

Die Dauer des dritten Zeitintervalls, in dem innerhalb der Halbleiterschicht Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung erzeugt werden, kann gleich der Dauer des ersten Zeitintervall sein. Dabei werden während des gesamten Prozessabschnitts des Verfahrens, bei dem die Halbleiterschicht eine Temperatur größer als die erste Temperatur hat, Minoritätsladungsträger generiert.

Das dritte Zeitintervall kann aber auch ganz oder teilweise außerhalb des ersten Zeitintervalls liegen. Dann wird die Schicht auch oder nur während der Aufheiz- und/oder Abkühlphase, oder eines anderen, vor oder nach dem ersten Zeitintervall liegenden, beliebigen Temperatur-Zeit-Prozeßschritts bestrahlt, innerhalb der die Schichttemperatur noch unterhalb der ersten Temperatur ist. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn ein Repassivieren aktivierter Fremdatome (z.B. Mg) durch Wasserstoff beim Abkühlen vermieden werden soll, oder wenn wie oben beschrieben, die erste Temperatur schon früher, d.h. bei einer niedrigeren Temperatur erreicht werden soll.

Insgesamt läßt sich durch die Lage und die Länge des zweiten und dritten Zeitintervalls, sowie durch die erste und die zweite Temperatur auch das räumliche Konzentrationsprofil der aktivierten und passivierten Fremdatome einstellen. Liegt die zweite Temperatur oberhalb der Zersetzungstemperatur, so ist auch die Defektkonzentration und deren räumliche Verteilung ebenso einstellbar. So kann z.B. das dritte Zeitintervall das zweite umfassen, gleich oder innerhalb des zweiten Zeitintervalls sein, vor dem zweiten Zeitintervall liegen, Zeitbereiche vor und aus dem zweiten Zeitintervall oder Zeitbereiche aus dem zweiten und nach dem zweiten Zeitintervall aber auch Zeitbereiche nach dem zweiten Zeitintervall umfassen.

Die Schichten können Gruppe III-V und/oder Gruppe II-VI der Verbindungshalbleiter umfassen, insbesondere Gruppe-III-Nitride wie z.B. GaN.

Die Energie der elektromagnetischen Strahlung des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens wird vorteilhaft größer als der Bandabstand wenigstens einer Schicht gewählt. Dadurch werden durch die elektromagnetische Strahlung Minoritätsträger innerhalb der Schicht produziert, wodurch die Aktivierung der durch Wasserstoff passivierten Fremdatome erleichtert, eine Repassivierung der Fremdatome vermieden und die Diffusion des Wasserstoffs unterstützt wird.

Vorteilhafterweise wird das erfindungsgemäße Verfahren wie oben erwähnt mittels eines Schnellheizsystems (RTP-Systems) durchgeführt, da mittels des RTP-Systems definiert sehr kurze Heizprozesse im Bereich von einer Sekunde bis hin zu 30 Minuten durchgeführt werden können. Die Temperatur-Zeit-Kurven der Substrate lassen sich in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis ca. 1400 C sekundengenau einstellen, wobei das Substrat sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen extrem gleichmäßig beheizt wird. Ebenso lassen sich in RTP-Systemen auch unterschiedliche Prozessgase, die das Substrat umgeben, verwenden, wobei der Prozessgasdruck von Vakuum- bis hin zu Überdruckbedingungen einstellbar ist.

Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Figuren näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch den Schichtwiderstand als Funktion der Temperatur und den Einfluß elektromagnetischer Strahlung auf diesen,

Fig. 2a bis 2f verschiedene schematisch dargestellte Temperatur-Zeit-Kurven für eine in einem RTP-System behandelte Halbleiterschicht.

In Fig. 1 zeigt Kurve a schematisch einen typischen Verlauf eines Schichtwiderstands eines Verbindungshalbleiters, z.B. eines mit Mg versetzten GaN-Films, als Funktion der Temperatur. Bei niedrigen Temperaturen (z.B. GaN bei unter ca. 550 °C) weist der Halbleiterfilm aufgrund der Passivierung der Fremdatome (z.B. Mg) durch Wasserstoff einen hohen elektrischen Widerstand

R auf. Mit zunehmender Temperatur verringert sich dieser, da immer mehr Wasserstoff-Akzeptor-(Fremdatom-) Komplexe aufbrechen und die Akzeptoren somit elektrisch aktiv werden. Sind alle Komplexe aufgebrochen und alle Akzeptoren aktiviert, so bleibt der Schichtwiderstand bei steigender Temperatur ab einem unteren Temperaturwert T_L bis zu einem oberen Temperaturwert T_H annähernd konstant. Ab dem oberen Temperaturwert T_H steigt der Schichtwiderstand R mit zunehmender Temperatur wieder deutlich an, da ab dieser Temperatur T_H eine Zersetzung der Halbleiterschicht auftritt. Bei Mg dotiertem GaN ist unter Atmosphärendruck T_L etwa 550 C und T_H etwa 1050 C.

10 Durch Erzeugung von Minoritätsladungsträger kann die Temperatur T_L verringert werden. Die Ladungsträger können dabei z.B. durch Bestrahlung mit UV-Licht erzeugt werden, wobei die eingestrahlte Photonenergie größer als der Bandabstand der Halbleiterschicht bei der entsprechenden Schichttemperatur ist. Die Ladungsträger können aber auch z.B. durch Anlegen eines Potentials oder einer Spannung an eine Halbleiterschicht bzw. an ein Halbleiterschichtsystem, oder durch Kombination von UV-Bestrahlung und einem Anlegen eines Potentials oder einer Spannung an die Schicht bzw. das Schichtsystem erzeugt werden. Die Verringerung des unteren Temperaturwertes T_L hängt von der Zahl der erzeugten Ladungsträger ab. Der untere Temperaturwert lässt sich mittels UV-Bestrahlung, z.B. im Falle von GaN mit einer Wellenlänge kleiner als etwa 360 nm, um ca. 100 C absenken, wie es in Fig. 1 mittels Kurve b dargestellt ist.

25 Fig. 2 a zeigt ein Beispiel einer Temperatur-Zeit-Kurve des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Halbleiterschicht oder allgemein das Halbleiterschichtsystem wird von Raumtemperatur (Punkt A) möglichst schnell auf die Temperatur T_1 , bei der der Schichtwiderstand des Halbleiters oder der Schichtwiderstand wenigstens einer Schicht des Halbleitersystems abnimmt (Punkt B), aufgeheizt. Nun wird für ein erstes Zeitintervall kleiner als 120 Sekunden (Zeitdifferenz BE zwischen B und E) die Temperatur der Halbleiterschicht oder des Halbleitersystems einer Schicht des Schichtsystems) über der Temperatur T_1 gehalten. Innerhalb

dieses ersten Zeitintervalls wird die Schicht für die Dauer eines zweiten Zeitintervalls (Zeitdifferenz CD zwischen Punkt D und C) auf eine zweite Temperatur T_2 erhitzt, wobei das zweite Zeitintervall kleiner 60 Sekunden ist. Die Temperatur-Zeit-Kurve kann innerhalb dieses zweiten Zeitintervalls im allgemeinen einen beliebigen Kurvenverlauf mit Schwankungen um bis zu 200 C um die zweite Temperatur T_2 aufweisen. Figur 2a zeigt für GaN ein T_1 von etwa 550 C und ein T_2 größer als die Zersetzungstemperatur von ca. 1050 C, weshalb das zweite Zeitintervall CD kleiner als 60 Sekunden, vorzugsweise kleiner als 30 Sekunden gewählt wird. Der untere Grenzwert für das zweite Zeitintervall ist im allgemeinen durch die Regelgeschwindigkeit bestimmt mit der der aufsteigende Teil der Temperaturzeitkurve (ramp up) in den abfallenden Teil (ramp down) übergeführt werden kann. Für moderne RTP-Systeme beträgt diese Zeit etwa 1 Sekunde. Mit zukünftigen Verbesserungen der RTP-Systeme kann dieser Wert unter Umständen unterschritten werden. Die Dauer des zweiten Zeitintervalls CD (in Fig 2a) bestimmt entscheidend, um wieviel die Temperatur T_2 die Zersetzungstemperatur T_H überschreiten kann, ohne das die Halbleiterschicht oder das Schichtsystem einen bleibenden Schaden erfährt. Je kürzer das zweite Zeitintervall CD ist, desto höher kann die Temperatur T_2 sein, da dann die insgesamt thermische Belastung der Schicht im Zeitintervall CD einen kritischen Wert nicht übersteigt. Liegt die thermische Belastung unterhalb dieses kritischen Wertes, so können abhängig vom Halbleitertyp die gebildeten Fehlstellen und Defekte durch ein anschließendes Annealing (Tempern) bei einer Temperatur kleiner als T_H größtenteils oder wenigstens zum Teil wieder beseitigt werden. Der kritische Wert der thermischen Belastung der Schicht oder des Schichtsystems ist experimentell zu ermitteln. Damit bei vorgegebener kritischer thermischer Belastung eine möglichst hohe Temperatur T_2 erzielbar ist, ist es wichtig, daß das RTP-System ein schnelles Aufheizen- bzw. Abkühlen des Halbleiters ermöglicht. Typische maximale Aufheizgeschwindigkeiten liegen anlagenabhängig zwischen 75 C/s und 500 C/s. Während des in Fig. 2a dargestellten Prozesses werden für die Dauer von zumindest einem dritten Zeitintervall durch elektromagnetische Strahlung, vorzugsweise durch UV-

Strahlung, innerhalb der Schicht Ladungsträger erzeugt. Dabei kann das dritte gleich dem ersten Zeitintervall BE sein, wodurch die freien Ladungsträger erst erzeugt werden, wenn die Mg- (oder allgemein Fremdatom-) Wasserstoff-Komplexe thermisch bereits nahezu aufgebrochen sind. Durch die (photo)generierten freien Elektronen ist dann das Diffusionsverhalten des aufgebrochenen Wasserstoffs innerhalb der Halbleiterschicht zu beeinflussen. Alternativ kann das dritte Zeitintervall auch das zweite BE oder den gesamten Prozeß AF umfassen. Allgemein kann das dritte Zeitintervall beliebig innerhalb des Prozesses AF liegen, wobei seine Dauer bis zur gesamten Prozeßzeit AF betragen kann. Die unter Grenze des dritten Zeitintervalls wird durch die technischen Möglichkeiten eine ausreichende UV-Lichtleistung bereitzustellen begrenzt. Sie liegt derzeit bei etwa 10^{-9} s für gepulste Laser und bei etwa 10^{-6} s für Blitzlampen. Bevorzugt werden jedoch Zeitintervalle von 1 bis 120 Sekunden. Insbesondere ist es vorteilhaft das dritte Zeitintervall während der Abkühlphase so zu legen, daß während des Abkühlens der Schicht eine Repassivierung der Fremdatome (z.B. des Mg in GaN) weitgehend verhindert wird. Ferner ist es auch vorteilhaft während der Aufheizphase, z.B. im Bereich AB oder AC durch UV-Einstrahlung Ladungsträger zu erzeugen, wodurch wie in Fig. 1 dargestellt, die erste Temperatur T_1 und somit auch die thermische Belastung des Halbleiters reduziert werden kann. Ferner können innerhalb des Prozesses AF in mehreren (dritten) Zeitintervallen Ladungsträger durch UV-Strahlung erzeugt werden. Beispielsweise lassen sich die oben genannten Vorteile kombinieren, indem man zwischen AB oder AC im ramp up und im ramp down Ladungsträger erzeugt.

Fig. 2b zeigt ein weiteres Beispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem die Temperatur T_2 unterhalb der Zersetzungstemperatur T_H liegt. Auch hier wird wenigstens eine Halbleiterschicht für wenigstens ein Zeitintervall BE kleiner 120 s auf eine Temperatur größer als die erste Temperatur T_1 geheizt und für ein zweites Zeitintervall CD kleiner 60 s auf einer Temperatur T_2 gehalten. Die

Länge des zweiten Zeitintervalls CD ist hier weniger kritisch, da die zweite Temperatur T_2 unterhalb der Zersetzungstemperatur T_H liegt. Die Lage und die Dauer des dritten Zeitintervalls kann entsprechend, wie oben in Verbindung mit Fig. 2a beschrieben, gewählt werden. Abhängig von der Beeinflussung der Diffusion des Wasserstoffs, der beim Aufbruch des Mg- (Fremdatom-) Wasserstoff-Komplexes entsteht, durch die durch die UV-Strahlung generierten freien Ladungsträger wird das dritte Zeitintervall in Lage und Dauer optimiert. Dies ist experimentell zu ermitteln und von der Halbleiterschicht abhängig. So kann es z.B. vorteilhaft sein, während des Prozeßbereichs AB (in Fig. 2b) die Schicht mit UV-Licht zu bestrahlen. Dadurch wird der Mg-H-Komplex schon bei niedrigen Temperaturen aufgebrochen. Während des Prozessabschnitts BD diffundiert der Wasserstoff mit sehr hoher Diffusionskonstante in die Oberflächenbereiche der Schicht. Während der Abkühlphase DF erfolgt eine erneute UV-Bestrahlung, um ein Repassivieren des Mg (der Fremdatome) in GaN (im II-VI oder III-V Halbleiter) zu verhindern. Insgesamt erhält man durch dieses Verfahren einen hohen Aktivierungsgrad.

In Fig 2c ist ein weiteres Ausführungsbeispiel dargestellt. Im Unterschied zu den vorherigen Beispielen wird die Halbleiterschicht im Temperaturbereich zwischen T_1 und T_H für ein Zeitintervall CD kleiner als 120 s getempert. Während dieser Zeit erfolgt die Aktivierung der Fremdatome durch Aufbruch des Wasserstoff-Fremdatomkomplexes und der Wasserstoff bzw. das Wasserstoffion diffundiert in Richtung Halbleiteroberfläche. Durch die weitere Temperaturerhöhung DEF wird die Wasserstoffdiffusion erhöht. Dabei kann die Temperatur wie in Fig. 2c dargestellt die Zersetzungstemperatur T_H übersteigen, oder wie Fig. 2d zeigt, unterhalb dieser liegen. Auch hier kann durch Lage und Dauer des dritten Zeitintervalls durch Bestrahlung mittels UV-Licht Einfluß auf den Aktivierungs- bzw. Repassivierungsgrad (bzw. deren räumlichen Verteilungen) genommen werden. Als zweites Zeitintervall bzw. zweite Temperatur T_2 kann in den Beispielen aus Fig. 2c und Fig. 2d sowohl das Zeitintervall CD als auch das

Zeitintervall EF mit der jeweiligen zugehörigen (mittleren) Temperatur angesehen werden. Vorzugsweise wird bedingt durch den Diffusion- und Aktivierungsmechanismus das Zeitintervall EF der höheren Temperatur wesentlich kürzer gewählt als das Zeitintervall CD. Zusammen sind die Intervalle kürzer als
5 120 s, welches die maximal zulässige Zeit für das erste Zeitintervall BG ist.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist in Fig. 2e dargestellt. Hier folgt im Unterschied zu Fig. 2c und Fig. 2d einem hohen Temperaturschritt EF, dem ein niedrigerer Temperaturschritt CD (etwa wie in Fig. 2c) vorausgeht, ein weiterer Temperaturschritt im Intervall GH. Dieser Schritt GH ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn durch einen hohen Temperaturschritt EF (der auch über der Zersetzungstemperatur liegen kann) merkliche Defektbildung (z.B. N-Fehlstellen in GaN) auftritt. Diese Defekte können dann je nach Halbleitermaterial im Schritt GH weitgehend oder wenigstens teilweise ausgeheilt werden. Auch in diesem Beispiel kann sowohl das Zeitintervall CD als
15 auch die Zeitintervalle EF und/oder GH als zweites Zeitintervall bzw. als zweite Zeitintervalle interpretiert werden, wobei dann die Intervalllänge kleiner als 60 s ist. Die Summe der Intervalle CD, EF und GH sind ebenfalls kürzer als 120 s, welches die maximal zulässige Zeit für das erste Zeitintervall BI ist. Bezüglich
20 der Lage und Dauer des dritten Zeitintervalls innerhalb dessen durch elektromagnetische Strahlung (z.B. UV-Licht) in der Halbleiterschicht Ladungsträger erzeugt werden gilt analog zu den vorhergehenden Ausführungsbeispielen, daß durch Bestrahlung mittels UV-Licht Einfluß auf den Aktivierungs- bzw. Repassivierungsgrad (bzw. deren Verteilungen) genommen wird. Hierzu wird die Lage
25 und die Dauer des dritten Zeitintervalls innerhalb des Prozesses AK geeignet gewählt, wobei wie oben beschrieben, vorzugsweise im Bereich des Hochheizens, also z.B. im Bereich AB oder AC und im Bereichen des Abkühlens, also z.B. in den Bereichen FG und / oder HI die Halbleiterschicht mit UV-Licht bestrahlt wird.

Durch Anlegen eines elektrischen Feldes an die Halbleiterschicht kann der Diffusionsprozeß des bei der Aktivierung entstehenden Wasserstoffs ebenfalls beeinflußt, d.h. die Diffusion durch die Halbleiterschicht beschleunigt werden. Dies kann z.B. dadurch erfolgen, daß das Substrat mit der Halbleiterschicht bzw. dem Halbleiterschichtsystem gegenüber dem Prozessgas, bzw. gegenüber einer über der Schicht beabstandet angeordneten Elektrode auf ein positives Potential gelegt wird. Eine derartige Anordnung oder ein derartiges Verfahren kann für sich oder in Kombination mit den oben dargestellten Verfahren angewandt werden. Allgemein kann im dritten Zeitintervall zusätzlich zu der elektromagnetischen Strahlung ein Potential in der beschriebenen Art und Weise eingesetzt werden, oder es kann während des dritten Zeitintervalls für alle oben beschriebene Fälle nur ein Potential zur Anwendung kommen, d.h., daß auf eine UV-Bestrahlung verzichtet wird. Wird während des dritten Zeitintervalls nur ein Potential oder ein Feld an die Schicht gelegt, so werden durch dieses nicht notwendigerweise Ladungsträger in der Schicht erzeugt. Alleine die Änderung des elektrochemischen Potentials ändert das Diffusionsverhalten des Wasserstoffs in der Schicht.

Patentansprüche:

- 5 1. Verfahren zur thermischen Behandlung von wenigstens einer Schicht, vorzugsweise bestehend aus Verbindungshalbleitern, zur Aktivierung von in der Schicht durch Wasserstoff passivierten Fremdatomen mit den Verfahrensschritten;

10

erwärmen von wenigstens einer Schicht auf eine Temperatur höher als eine erste Temperatur, bei der der spezifische Schichtwiderstand abnimmt, für ein erstes Zeitintervall kleiner als 120 sec,

15

innerhalb des ersten Zeitintervalls erwärmen von wenigstens einer Schicht auf eine zweite Temperatur höher als die erste Temperatur für ein zweites Zeitintervall von bis zu 60 sec

20

wobei während des Verfahrens in wenigstens einem dritten Zeitintervall durch elektromagnetische Strahlung innerhalb der Schicht Ladungsträger erzeugt werden.

25

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Temperatur zwischen 300 C und 1200 C ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Temperatur zwischen 600 C und 1200 C ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es außerhalb des ersten Zeitintervalls thermische Verfahrensschritte bei Temperaturen T kleiner T_1 beinhaltet.

30

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß

das dritte Zeitintervall teilweise außerhalb des ersten Zeitintervalls liegt.

5 6. Verfahren nach einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte Zeitintervall gleich dem ersten ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte Zeitintervall außerhalb des ersten Zeitintervalls ist.

10 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte Zeitintervall das zweite Zeitintervall umfaßt.

15 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung zeitlich vor dem zweiten Zeitintervall gebildet werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung zeitlich vor und während des zweiten Zeitintervalls gebildet werden.

20 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung während und nach dem zweiten Zeitintervall gebildet werden.

25 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung nach dem zweiten Zeitintervall gebildet werden.

30 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung nur vor und nach dem zweiten Zeitintervall gebildet werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungsträger durch elektromagnetische Strahlung innerhalb des zweiten Zeitintervalls gebildet werden.

5

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Schicht Verbindungshalbleiter der Gruppe III-V umfaßt.

10

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Schicht Verbindungshalbleiter der Gruppe II-VI umfaßt.

15

17. Verfahren nach Ansprüchen 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Schicht Verbindungshalbleiter der Gruppe III-Nitride umfaßt.

20

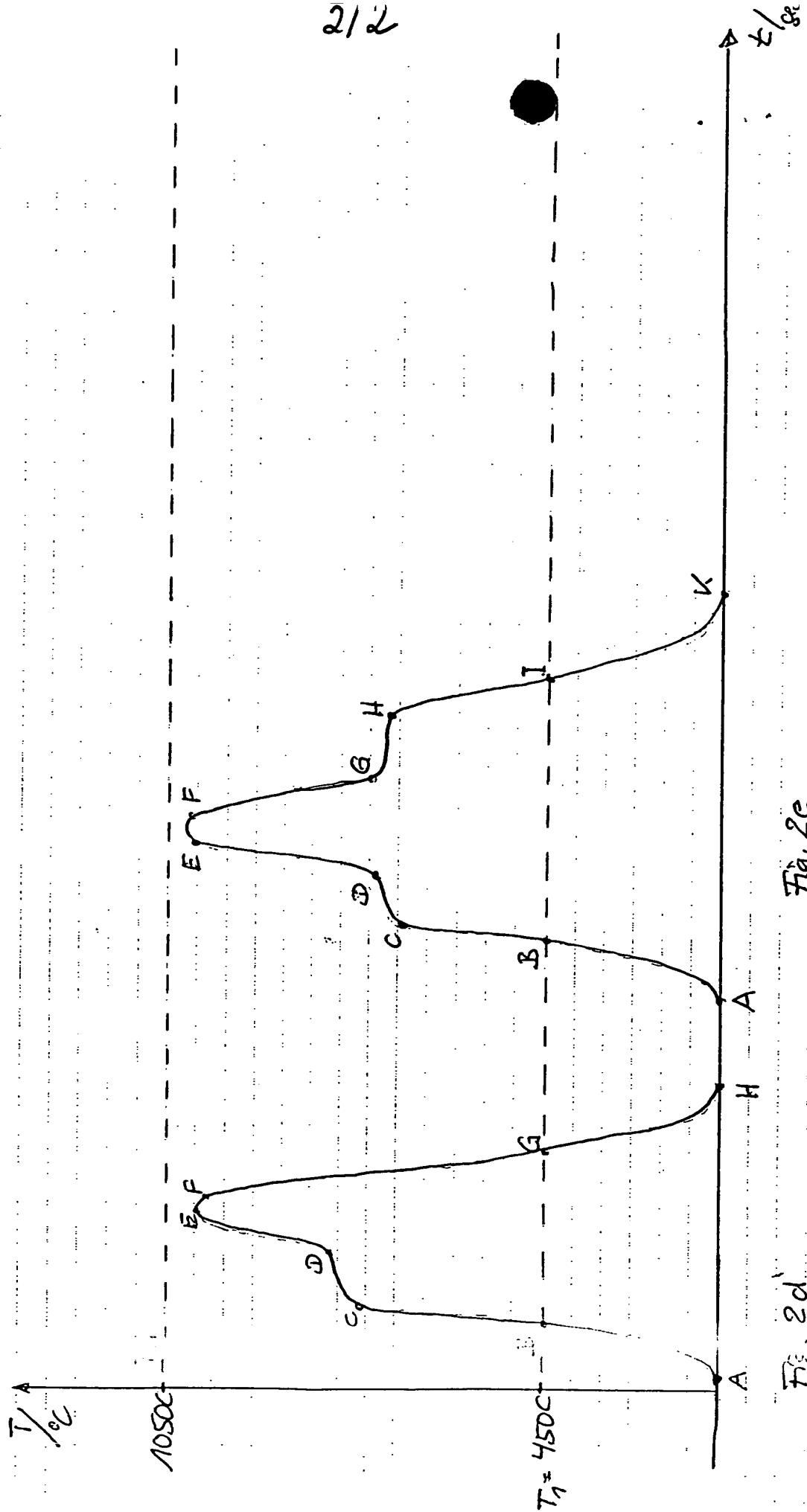
18. Verfahren nach wenigstens einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Energie der elektromagnetischen Strahlung größer als der Bandabstand wenigsten einer Schicht ist.

25

19. Verfahren nach wenigstens einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die thermische Behandlung der Schicht innerhalb eines RTP-Systems erfolgt.

Zusammenfassung:

- Verfahren zur thermischen Behandlung von wenigstens einer Schicht, vorzugsweise bestehend aus Verbindungshalbleitern, zur Aktivierung von in der Schicht durch Wasserstoff passivierten Fremdatomen. Das Verfahren umfaßt
- 5 das Erwärmen von wenigstens einer Schicht auf eine Temperatur höher als eine erste Temperatur, bei der der spezifische Schichtwiderstand abnimmt, für ein erstes Zeitintervall kleiner als 120 sec, wobei innerhalb des ersten Zeitintervalls wenigstens eine Schicht auf eine zweite Temperatur höher als die erste Temperatur für ein zweites Zeitintervall von bis zu 60 sec erwärmt wird. Ferner werden während des Verfahrens in wenigstens einem dritten Zeitintervall durch elektromagnetische Strahlung innerhalb der Schicht Ladungsträger erzeugt.



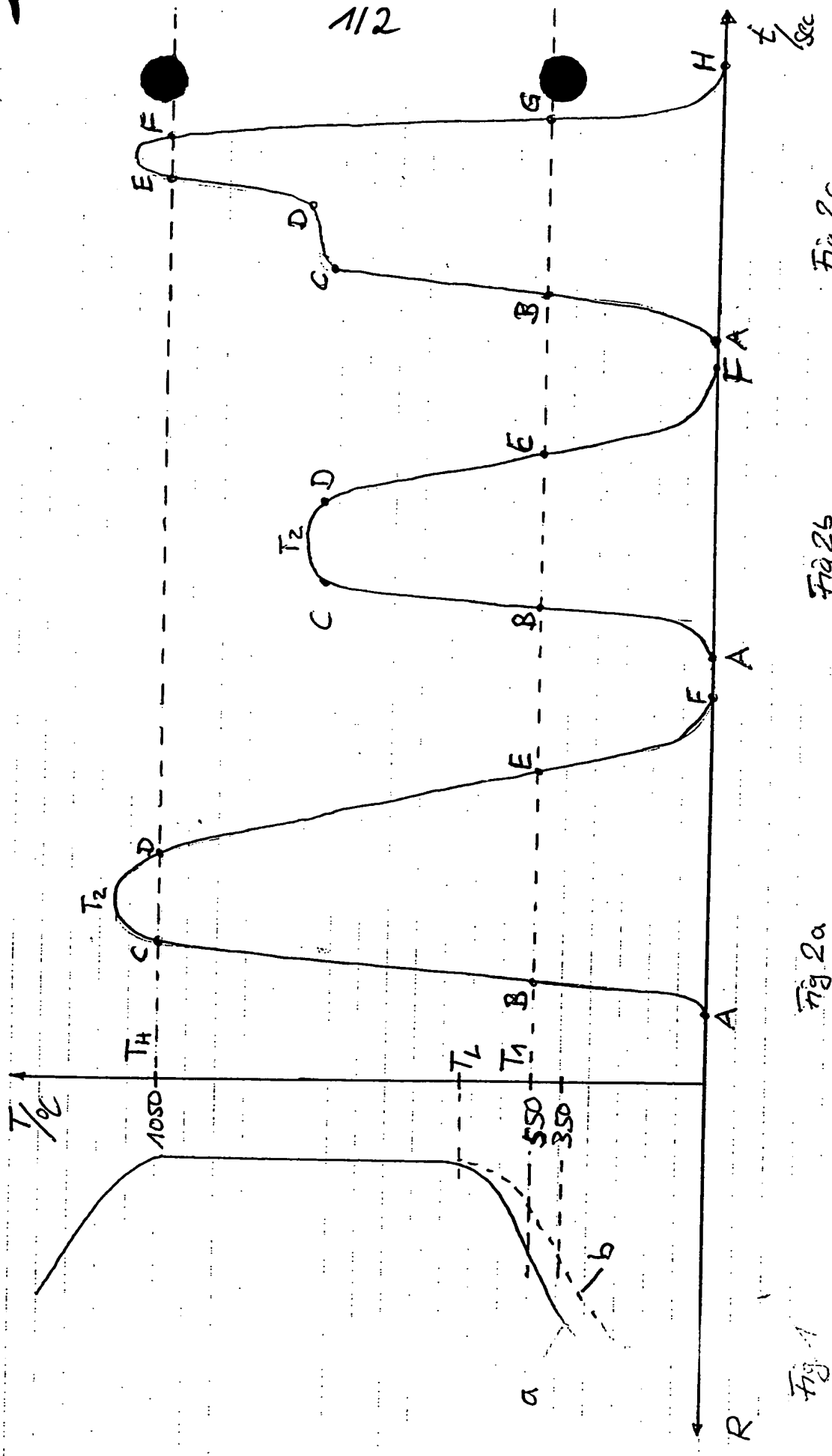


Fig 1

Fig 2a

Fig 2b

Fig 2c

THIS PAGE BLANK (USPTO)